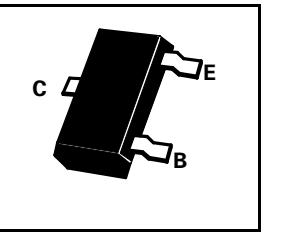
SuperSOT
SOT23 NPN SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTORS

ISSUE 3 - NOVEMBER 1995

FMMT617 FMMT618 FMMT619 FMMT624 FMMT625

FEATURES

* **625mW POWER DISSIPATION**
* **I_C CONT 3A**
* 12A Peak Pulse Current
* Excellent H_{FE} Characteristics Up To 12A (pulsed)
* Extremely Low Saturation Voltage E.g. 8mV Typ.
* Extremely Low Equivalent On Resistance; **$R_{CE(sat)}$**



DEVICE TYPE	COMPLEMENT	PARTMARKING	$R_{CE(sat)}$
FMMT617	FMMT717	617	**50mΩ at 3A**
FMMT618	FMMT718	618	**50mΩ at 2A**
FMMT619	FMMT720	619	**75mΩ at 2A**
FMMT624	FMMT723	624	-
FMMT625	–	625	-

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	FMMT 617	FMMT 618	FMMT 619	FMMT 624	FMMT 625	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	15	20	50	125	150	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	15	20	50	125	150	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	5	5	5	5	V
Peak Pulse Current**	I_{CM}	12	6	6	3	3	A
Continuous Collector Current	**I_C**	**3**	**2.5**	**2**	**1**	**1**	**A**
Base Current	I_B	500					mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C*	**P_{tot}**	**625**					**mW**
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +150					°C

* Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on a ceramic substrate measuring 15x15x0.6mm

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤ 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

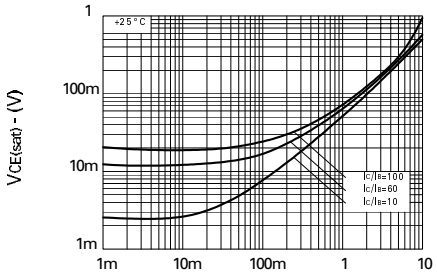
FMMT617

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	15	70		V	I_C=100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	15	18		V	I_C=10mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5	8.2		V	I_E=100μA
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			100	nA	V_{CB}=10V
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			100	nA	V_{EB}=4V
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}			100	nA	V_{CES}=10V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		8 70 150	14 100 200	mV mV mV	I_C=0.1A, I_B=10mA* I_C=1A, I_B=10mA* I_C=3A, I_B=50mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	1.0	V	I_C=3A, I_B=50mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.84	1.0	V	I_C=3A, V_{CE}=2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	200 300 200 150	415 450 320 240 80			I_C=10mA, V_{CE}=2V* I_C=200mA, V_{CE}=2V* I_C=3A, V_{CE}=2V* I_C=5A, V_{CE}=2V* I_C=12A, V_{CE}=2V*
Transition Frequency	f_T	80	120		MHz	I_C=50mA, V_{CE}=10V f=50MHz
Output Capacitance	C_{obo}		30	40	pF	V_{CB}=10V, f=1MHz
Turn-On Time	$t_{(on)}$		120		ns	V_{CC}=10V, I_C=3A I_{B1}=I_{B2}=50mA
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		160		ns	

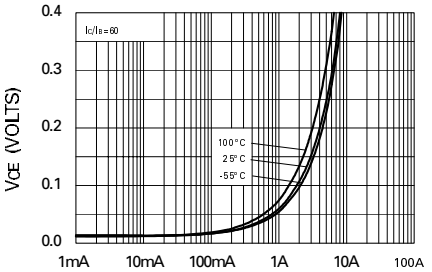
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

TYPICAL CHARACTERISTICS



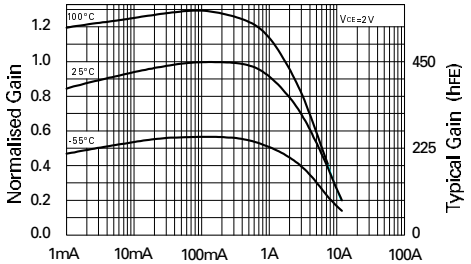
IC - Collector Current (A)

VCE(SAT) v IC



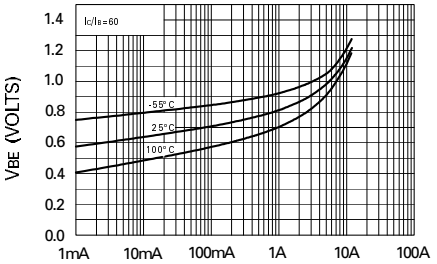
Collector Current

VCE(SAT) vs IC



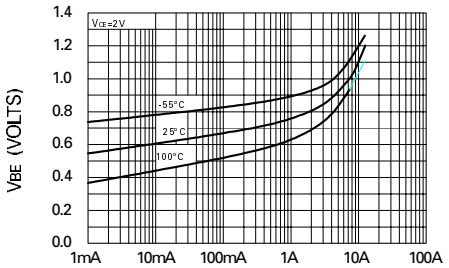
Collector Current

hFE vs IC



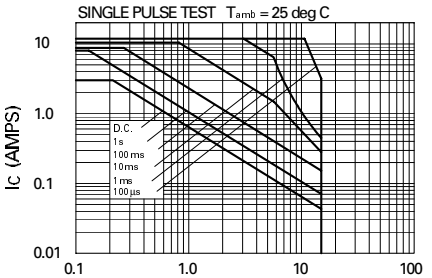
Collector Current

VBE(SAT) vs IC



Collector Current

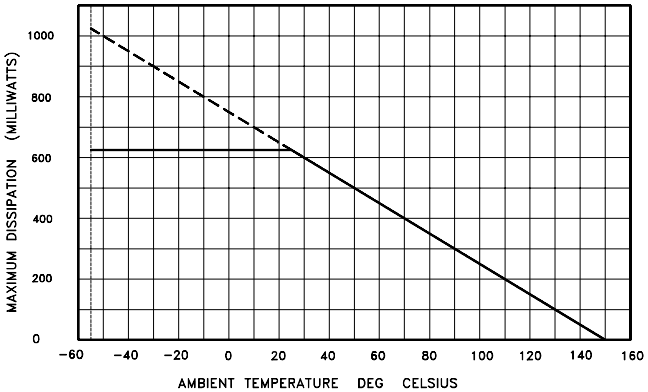
VBE(ON) vs IC



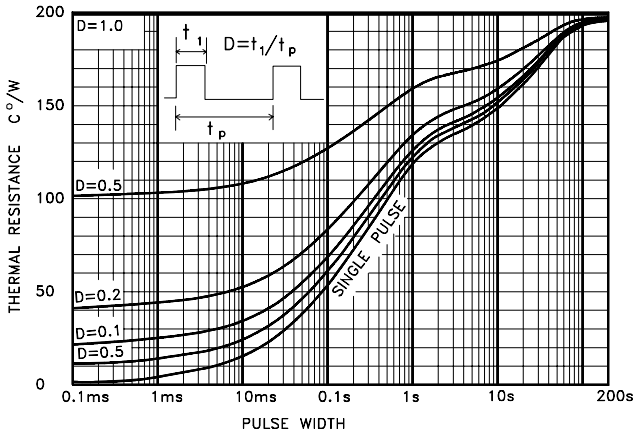
VCE (VOLTS)

Safe Operating Area

THERMAL CHARACTERISTICS AND DERATING INFORMATION



DERATING CURVE



MAXIMUM TRANSIENT THERMAL RESISTANCE

* Reference above figures, Devices were mounted on a 15mmx15mm ceramic substrate

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.